文章编号:0258-7025(2002)11-0987-04

# 本征平坦增益带宽 > 33 nm 的高增益、 低噪声 *L*-波段铒光纤放大器

### 张岩滨,彭江得,刘小明

(清华大学电子工程系,北京 100084)

提要 对掺铒光纤 *L*-波段的增益谱特性进行了理论模拟与实验,确定了形成平坦增益谱的最佳粒子数反转条件 (~40%)采用两段级连分配抽运放大光路,小信号增益>36 dB,最低噪声系数<4.4 dB,在不加增益平坦滤波器 的条件下,23±0.5 dB的本征平坦增益带宽达到33.5 nm(1569~1602.5 nm)。 关键词 掺铒光纤放大器,*L*-波段,波分复用 中图分类号 TN 929.11 文献标识码 A

## *L*-band Erbium Doped Fiber Amplifier with Intrinsic Gain Flattering Bandwidth of > 33 nm

ZHANG Yan-bin , PENG Jiang-de , LIU Xiao-ming

( Department of Electronic Engineering, Tsinghua Univsity, Beijing 100084)

**Abstract** The characteristics of *L*-band erbium doped fiber are investigated by numerical simulation and experiment. Gain spectrum is flat on optimum population inversion level (~40%). High gain (>36 dB) and low noise (<4.4 dB) are achieved with dual-stage configuration. The flattened amplification bandwidth is 33.5 nm ( $\pm$  0.5 dB)(1569 ~ 1602.5 nm) without gain equalized filter (GEF).

Key words erbium doped fiber amplifier (EDFA), L-band, wavelength division multiplexer (WDM)

## 1 引 言

随着大容量宽带光通信网络的加速发展,工作 在 *C*-波段(1.52~1.56 μm)的掺铒光纤放大器(*C*-EDFA)的增益带宽已不能满足要求。采用长的掺 铒光纤(EDF)并降低粒子数反转水平,可使 EDFA 工作在 1.57~1.61 μm 波长范围(称为 *L*-波段)。 将 *C*-EDFA 与 *L*-EDFA 并联使用,实现了超宽带的 光放大 增益带宽扩展到 70~80 nm<sup>[1]</sup>。

与 C-EDFA 相比, L-EDFA 的光放大过程有两 点显著的差别:一是 EDF 在 L-波段的单位长度增 益很低,要获得高增益需要较长的光纤;二是在长的 EDF 中, 980 nm 或 1480 nm 抽运光在靠近抽运源 的光纤段中已经基本耗尽,在剩余光纤段中传播的 主要是 *C*-波段放大的自发辐射(*C*-ASE)和被放大的 *L*-信号光;而这部分 *C*-ASE 将被再吸收而成为 *L*-信号光放大的二次抽运源<sup>2]</sup>。因此,如何适当配 置抽运功率与 EDF 长度以实现最大的增益谱平坦 度,如何有效地控制 *C*-ASE 以改善噪声特性,又充 分利用 *C*-ASE 来提高整体抽运效率,便成为实现 *L*-EDFA 高增益、低噪声、宽频带放大的关键问题。

本文报道了对 *L*-波段 EDF 本征平坦增益谱特 性进行的理论模拟与实验结果,并确定了形成平坦 增益谱的最佳粒子数反转条件(~40%)。采用级连 分配抽运放大光路,通过对 *C*-ASE 进行有效调控, 小信号增益可达到 > 36 dB,最低噪声系数 < 4.4 dB;在不另加增益平坦滤波器的情况下 23±0.5 dB 的本征平坦增益带宽达到 33.5 nm(1569~1602.5

收稿日期 2001-08-06;收到修改稿日期 2001-11-05

作者简介 张岩滨 1969—) 男 ,1998 年至今在清华大学电子工程系攻读博士学位。主要研究掺铒光纤放大器。E-mail: zhangyanbin98@mails.tsinghua.edu.cn

nm )。

988

#### 2 L-EDFA 的本征平坦增益谱特性

掺铒光纤在波长  $\lambda_k$  处的增益  $g_k$  与粒子数反转 之间的关系式为<sup>[3]</sup>

 $g_k(dB) = L\left[\left(\alpha_k + g_k^*\right) - \frac{n_2}{n_k} - \alpha_k\right] \quad (1)$ 

其中, L 为掺铒光纤的长度,  $a_k$  和 $g_k^*$  分别为波长 $\lambda_k$ 处实测的吸收系数和发射系数,  $n_t$  为铒离子的线密 度,  $n_2 = \frac{1}{L_0} \int_0^t n_2(z) dz$  为整个掺铒光纤的平均上 能级粒子数线密度。从(1)式可以看出, 在光纤参数 和长度确定的条件下, 增益谱形状只和总的平均粒 子反转水平有关, 在此条件下的放大器增益唯一地 由 EDF 长度决定。

采用如图 1 所示的实验装置,使用的 EDF 数值 孔径 NA = 0.257,截止波长 1210 nm,对信号光和 抽运光的吸收系数分别为 16.77 dB/m(1529 nm), 8.68 dB/m(979 nm)和 7.67 dB/m(1480 nm)。采 用 980 nm 正向抽运和 1480 nm 反向抽运,以便获 得较低的噪声系数和较高的抽运效率。前端置光隔 离器以防止输入端光反馈;后端接光循环器,除用来 隔离输出端光反馈之外,还同时兼作反向抽运光的 输入接口和放大信号光的输出接口。采用光谱仪 (AO-6317,ANDO)对输入、输出光谱进行观测。





EDFA的波分复用(WDM)增益谱采用宽谱法 进行测量<sup>[4]</sup>,即采用适当波长和相当于多信道输入 总功率的饱和激光信号将 EDFA 的粒子数反转箝 制在相应的水平,用小功率的宽谱探测信号源 (BBS)一次性测出整个谱宽范围内多信道的增益 谱。实验中采用波长为 1586 nm 的半导体激光器 作饱和信号源,功率为 30 µW;采用掺铒光纤的 ASE 谱作为探测信号源,功率为 0.3 μW 相比于较 高功率的饱和光信号而言,BBS 功率对粒子数反转 水平的影响可忽略。980 nm 抽运功率固定在 100 mW 通过改变 1480 nm 抽运功率调整粒子数反转 水平使增益谱趋于平坦。

图 2 为实验测得的增益谱,其中虚线是数值模 拟结果。由图可见,通过调整粒子数反转水平, EDFA 在 1570~1600 nm 波长范围内可获得比较平 坦的增益谱;EDF 的本征增益谱在 *L*-波段有两个 峰峰值分别在 1573 nm 和 1594 nm。调整抽运功 率可以使这两个波长峰值增益相同,此时 *L*-EDFA 的增益谱最为平坦,在约 32 nm 宽(1570~1602 nm)的波长范围内增益谱的不平坦度小于±0.5 dB。当 EDF 长度为 50 m时,平坦增益为 32 dB。 当 EDF 长度为 40 m时,平坦增益为 22 dB,实验结 果同数值模拟结果非常吻合。当光纤长度确定后, 平坦增益的大小也就决定了,所以在设计增益谱平



坦的 EDFA 时,首先根据要求达到的平坦增益确定 所需 EDF 的总长度。

图 3 给出当 EDF 为 50 m 时测得的放大器增 益、噪声系数与输出光功率的关系曲线。由图可见, 1586 nm 波长的小信号增益大于 36 dB,噪声系数 小于 6.5 dB。这说明尽管单段掺铒光纤的 *L*-EDFA 可获得足够增益的宽带光放大,但噪声系数 较大,这主要是由于反向 ASE 的饱和作用降低了近 抽运端 EDF 段的粒子数反转水平所造成的。

#### 3 级连 *L*-EDFA 的放大特性

对 *L*-EDFA 抽运效率的研究表明<sup>51</sup>,*C*-ASE 对 *L*-波段的光放大器有二次抽运的重要作用,与 *L*-信 号光同方向注入 *C*-ASE(或激光)可以显著提高抽 运效率,且对噪声系数的影响不大,甚至在一定条件 下还可改善噪声特性。在单段光纤的 *L*-EDFA 中, 反向 *C*-ASE 不仅使输入光纤段的粒子数反转度降 低,导致增益和噪声特性变坏,而且还因其从输入端 漏出而不能对 *L*-波段的放大进行二次抽运,致使抽 运效率降低。因此,实用的 *L*-EDFA 宜采用级连放 大的光路结构。

类似于常见的两段级连 *C*-EDFA ,通过级间串 接的光隔离器阻挡后级 EDF 产生的反向 ASE 进入 前级 EDF ,使前级 EDF 处于高反转的低噪声放大状态 ,后级 EDF 处于低反转的高功率放大状态 ,从而 同时实现低噪声和高功率的放大。而且 ,既然 *C*-ASE 对 *L*-波段放大的抽运效率有重要作用 ,从前级 注入后级的正向 *C*-ASE 成为 *L*-波段放大的二次抽 运源 ,这些因素都将导致整体抽运效率的提高。

考虑到 C-ASE 在 L-EDFA 中的特殊作用,前 后两级 EDF 的长度比例与抽运功率的配置与 C-EDFA 的参量设计有很大不同,需要进行精细的模 拟设计。图 4 是模拟计算的放大增益和噪声系数 (NF)与光纤配比之间的关系。从增益与光纤配比 关系曲线上,可以看出第一段光纤(EDF1)所占比例 小于 5%之前,信号的增益随 EDF1 所占比例的增 加而迅速增大。EDF1 所占比例大于 5%之后,信号 的增益仍随 EDF1 所占比例增加而增大,但是增大 的速度变缓,而且与最高增益(30%时)的差别不大, 只要 EDF1 的比例大于 5%,级连放大器就工作在 较高的抽运转换效率下。在 NF 与光纤配比曲线 上,当 EDF1 所占比例大约为 6.3%(2.7 m)时,放 大器的 NF 有最小值。综合考虑抽运效率和 NF. L- 波段级连掺铒光纤放大器的结构特点是第一级 EDF所占比例非常小,同时它的抽运功率也较小。



图 4 级连 *L*-EDFA 增益、噪声系数与光纤配比关系 Fig.4 Gain and NF vs proportion to tatal EDF

优化设计后的两段级连结构的 EDFA 如下:*L*-波段 EDF 总长度 43 m,其本征平坦增益在 23 dB 左 右。其中 2.7 mEDF 作预放级,预放级采用 60 mW 的 980 nm(LD1)反向抽运,一来减小输入 WDM 耦 合器损耗对噪声系数的净影响,使 NF 降低;二来可 增强向后级正向注入的 *C*-ASE,经后级进一步放大 后即构成有效的 *C*-ASE 二次抽运源,以利提高抽运 效率。后级主放大采用 40.3 m 的 EDF,并采用 180 mW 的 980 nm(LD2)正向抽运。980 nm 正向抽运 可以减小后级放大的 NF,从而降低 EDFA 的总的 NF 同时 980 nm 抽运对前级注入的 *C*-ASE 的放 大,有效地增强了后级放大中 *C*-ASE 的二次抽运作 用。图 4 的实验结果也证明了此优化后的放大器增



图 5 级连 L-EDFA 增益谱 Fig.5 Gainspectrum of dual-stage L-EDFA

益较高而 NF 较低 ,并且实验结果与理论模拟符合 较好。

考虑实际密集波分复用(DWDM)系统对 *L*-波 段 EDFA 传输带宽的要求,在采用宽谱法测量增益 带宽时,将饱和信号源功率增大到 200  $\mu$ W,ASE 宽 谱信号源功率取为 2.5  $\mu$ W。图 5 给出实验测量的 增益谱,虚线是数值模拟结果,在约 33.5 nm 宽 (1569~1602.5 nm)的波长范围内增益为 23.1 dB, 增益谱的不平坦度小于 ± 0.5 dB,理论模拟与实验 结果一致。

图6为实验测得的放大器增益、噪声系数与输



图 6 级连 L-EDFA 增益、噪声系数与输出功率关系曲线

Fig. 6 Gain and NF vs output power in dual-stage L-EDFA 出光功率的关系曲线。实验结果说明,与图 3 所示 单段光纤 *L*-EDFA 的放大特性相比,这种优化设计 的两段级连 *L*-EDFA 的噪声系数大大降低。在输 入信号功率 – 20 dBm 时,NF 小于 4.4 dB,小信号 增益大于 36 dB。

#### 参考文献

- Y. Sun, J. W. Sulhoff, A. K. Srivastavva. 80 nm ultrawideband erbium-doped silica fibre amplifier [J]. *Electron*. *Lett.*, 1997, 33(23):1965 ~ 1967
- 2 Hirotaka Ono, Makoto Yamada, Terutoshi Kanamori et al.. 1. 58-μm band gain-flatenned erbium-doped fiber amplifiers for WDM transmission systems [J]. J. Lightwave Technol., 1999, 17(3):490~496
- 3 C. R. Giles, E. Desurvire. Modeling erbium-doped fiber amplifiers [J]. J. Lightwave Technol., 1991, 9(2):271 ~283
- 4 Yuan Wei, Liu Xiaoming, Li Qun *et al*.. Iterative measurement of EDFA multichannel gain spectrum [J]. *Acta Electronic Sinica*(电子学报),1999,27(5):40~42 (in Chinese)
- 5 Zhang Yanbin, Liu Xiaoming, Peng Jiangde. L-band EDFA Efficiency Enhancement and Dynamic Range Extension by C-band Laser Injection [C]. Asia-Pacific Optical and Wireless Communications (APOC2001), Passive Components and Transmission Systems, 164
- 6 H. S. Chung, M. S. Lee, D. Lee et al.. Low noise, high efficiency L-band EDFA with 980 nm pumping [J]. Electron. Lett., 1999, 35(13):1099~1100